

DE 19536523 A1

For the production of a gate electrode, in a microelectronic circuit, a gate oxide (2) is formed on a substrate (1). An auxiliary layer is deposited, and structured at the gate electrode position. A layer is deposited, of a material to form the gate electrode, and a spacer (5) is etched on it. The auxiliary layer is removed, and the spacer (5) is used as the gate electrode. A silicide is used to form the spacer. The gate oxide layer (2) carries a layer (3) of polysilicon applied in a plasma chemical vapour deposition process.

⑯ BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENTAMT

⑯ ⑯ Offenlegungsschrift
⑯ ⑯ DE 195 36 523 A 1

⑯ Int. Cl. 5:
H 01 L 21/336

⑯ Aktenzeichen: 195 36 523.2
⑯ Anmeldetag: 29. 9. 95
⑯ Offenlegungstag: 3. 4. 97

⑯ Anmelder:
Siemens AG, 80333 München, DE

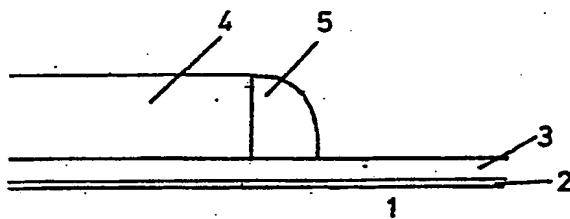
⑯ Erfinder:
Rauter, Gerhard, 93161 Sinzing, DE; Enders, Gerhard, Dipl.-Phys., 82140 Olching, DE

⑯ Entgegenhaltungen:
US 49 92 387
US 43 58 340
EP 02 23 994 A2

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

⑯ Verfahren zur Herstellung einer Gateelektrode

⑯ Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer Gateelektrode in einer mikroelektronischen Schaltung. Dabei wird erfindungsgemäß eine Hilfschicht aufgebracht und diese strukturiert und an den so erzeugten Flanken ein Spacer erzeugt, der direkt zur Bildung der Gateelektrode verwendet wird.



DE 195 36 523 A 1

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

BUNDESDRUCKEREI 02. 97 702 014/285

4/22

DE 195 36 523 A 1

Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer Gateelektrode in einer integrierten Schaltung.

Bei Halbleiterprodukten mit extrem hoher Integrationsdichte, beispielsweise bei integrierten Halbleiter-Speichern, ist vielfach die Strukturfeinheit der Fotolithographie der limitierende Faktor.

Zudem treten bei der Strukturierung der einzelnen Ebenen einer Halbleiterschaltung in der Regel unerwünschte Schwankungen der Breite des Fotolacks auf. Solche Schwankungen können durch Schichtdicken-Schwankungen des Fotolacks, Schwankungen der Lichtempfindlichkeit des Fotolacks, einer nicht optimalen Fokusinstellung am Belichtungsgerät, oder geringfügigen Schichtdickenschwankungen von Schichten unter dem Fotolack hervorgerufen werden. Ebenso können Schwankungen der Schichtreflexion der unter dem Fotolack liegenden Schicht sowie generell eine zu hohe Reflektivität der Schicht unter dem Fotolack zu Ungenauigkeiten bei der Strukturierung führen.

Daher werden die Schwankungen der oben genannten Parameter mit hohem Kontrollaufwand möglichst klein gehalten. Weiterhin ist es nötig einen Sicherheitsvorhalt in der Strukturgröße einzubauen, um bei den unvermeidlichen Schwankungen keine Ausfälle oder Beeinträchtigungen der elektrischen Funktion zu erhalten.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren der eingangs genannten Art zu schaffen, mit dem auf besonders einfache und präzise Weise sublithographische Strukturen und insbesondere Gateelektroden geschaffen werden können.

Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt mit den Merkmalen des Anspruchs 1. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen beschrieben.

Nach dem Grundgedanken der Erfindung wird auf einem Substrat ein Gateoxid erzeugt, eine Hilfsschicht abgeschieden und an der Stelle, an der die Gateelektrode erzeugt werden soll, strukturiert, eine Schicht eines Materials, das die Gateelektrode bildet, abgeschieden, aus dieser Schicht ein Spacer geätzt, die Hilfsschicht entfernt und der Spacer als Gateelektrode verwendet.

Das erfindungsgemäße Verfahren ermöglicht die Herstellung von sublithographischen Strukturen. Die Größe des Spacers und damit der Gateelektrode hängt nun nur von der Dickenschwankung der abgeschiedenen Schicht ab. Da sich die Schichtdickenschwankungen in engeren Grenzen beherrschen lassen als die Schwankungen eines Fototechnik-Lackmaßes, erhält man eine schmalere Verteilung der Strukturbreiten. Insbesondere ist durch dieses Verfahren auch gewährleistet, daß mit immer kleiner werdenden Strukturen unabhängig von topographischen Voraussetzungen auch die Strukturbreitenschwankung reduziert wird.

Weiterhin ist herauszustellen, daß zur Erzeugung von sublithographischen Strukturen der so erzeugte Spacer auch als Ätzmaske verwendet werden könnte. Ein Vorteil der Erfindung liegt jedoch darin, daß der Spacer direkt die zu erzeugende Struktur bildet, wodurch eine Vereinfachung und eine besonders präzise Durchführung des Verfahrens erreicht wird.

Die zur Spacerbildung und Gateelektrodenherstellung verwendete Schicht besteht üblicherweise aus Polysilizium. In einer Weiterbildung der Erfindung wird zur Spacerbildung Silizid eingesetzt.

Auf das Gateoxid wird in einer besonders günstigen Ausführungsform des Verfahrens zunächst eine dünne

Schicht Polysilizium mit einer Dicke von ca. 100 nm aufgebracht. Diese dient als Ätzstop bei der Entfernung der Hilfsschicht, die üblicherweise aus CVD-Oxid besteht, um das unter der Polysiliziumschicht liegenden Gateoxid zu schützen.

Die Verwendung von Plasma-CVD im Abscheide- oder Ätzmodus ist besonders bevorzugt, da dadurch das Verfahren auch bei niedrigen Temperaturen von ungefähr 400°C angewandt werden kann.

10 Auch zur Strukturierung von Mehrlagenschichten wie bei 4M, 16M oder 64M Speicherbausteinen ist das Verfahren geeignet.

Zudem kann durch das erfindungsgemäße Verfahren auf den Einsatz von teurem Maskenmaterial, wie z. B. Phasenmasken, verzichtet werden. Weiterhin können sehr kostenaufwendige Lithographieverfahren, wie z. B. Röntgenlithographie, ersetzt werden.

15 Nachfolgend wird das erfindungsgemäße Verfahren unter Bezugnahme auf die Zeichnung näher erläutert. Die einzige Figur zeigt den Schichtaufbau nach Ablauf eines Teils des Herstellungsverfahrens.

Auf einem Siliziumsubstrat 1 wird in einem Vorprozeß ein Gateoxid 2 erzeugt. Im nächsten Schritt wird eine dünne Polysiliziumschicht 3 von ca. 100 nm abgeschieden. Diese kann eventuell auch im Plasma-CVD-Verfahren abgeschieden werden. Im nächsten Schritt wird eine relativ dicke Oxidschicht 4 mit einer Dicke von ca. 0,5 bis 1 µm abgeschieden. Dies erfolgt ebenfalls im CVD-Verfahren (chemical vapor deposition). Die

25 Oxidschicht 4 wird im nächsten Schritt fotolithographisch strukturiert, wobei insbesondere die Stellen strukturiert werden, an denen das Gate erzeugt werden soll. An den Flanken der so strukturierten Oxidschicht 4 werden Spacer 5 durch konforme Abscheidung einer Polysiliziumschicht und anschließende anisotrope Ätzung erzeugt. Dieser Verfahrensstand ist in der Figur dargestellt. Beim Ätzen der Spacer 5 ist darauf zu achten, daß die dünne Polysiliziumschicht 3 nicht durchgeätzt wird. Mit einer Fototechnik werden im nächsten Schritt freie Gebiete abgedeckt. Die Oxidschicht 4, die nur hilfsweise aufgebracht wurde, um an den in ihr erzeugten Flanken die Spacer 5 ätzen zu können, wird durch einen Ätzschritt entfernt. Die dünne Polysiliziumschicht 3 dient dabei als Ätzstop und als Schutz für die darunter liegende Gateoxidschicht 2. Ebenso werden die zuvor mit der Fototechnik abgedeckten freien Gebiete vor einer unbeabsichtigten Ätzung geschützt.

30 Nach dem Ätzen der Oxidschicht 4 wird der bei der Fototechnik aufgebrachte Lack wieder entfernt. Der aus Polysilizium gebildete Spacer 5 wird jetzt als Gateelektrode verwendet und entsprechend durchstrukturiert. In Bereichen, an denen kein Polysilizium bleiben soll, wird dieses entfernt. Die Polysiliziumschicht 3 kann problemlos entfernt werden, da diese im Vergleich zu

40 der Gateelektrode sehr dünn ist und bei einer anisotropen Ätzung die Gateelektrode nur unwesentlich kleiner wird.

45 Im folgenden kann der Prozeß in üblicher Weise fortgesetzt werden. Hier bietet sich auch das CMP-Verfahren an.

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

145

150

155

160

165

170

175

180

185

190

195

200

205

210

215

220

225

230

235

240

245

250

255

260

265

270

275

280

285

290

295

300

305

310

315

320

325

330

335

340

345

350

355

360

365

370

375

380

385

390

395

400

405

410

415

420

425

430

435

440

445

450

455

460

465

470

475

480

485

490

495

500

505

510

515

520

525

530

535

540

545

550

555

560

565

570

575

580

585

590

595

600

605

610

615

620

625

630

635

640

645

650

655

660

665

670

675

680

685

690

695

700

705

710

715

720

725

730

735

740

745

750

755

760

765

770

775

780

785

790

795

800

805

810

815

820

825

830

835

840

845

850

855

860

865

870

875

880

885

890

895

900

905

910

915

920

925

930

935

940

945

950

955

960

965

970

975

980

985

990

995

1000

1005

1010

1015

1020

1025

1030

1035

1040

1045

1050

1055

1060

1065

1070

1075

1080

1085

1090

1095

1100

1105

1110

1115

1120

1125

1130

1135

1140

1145

1150

1155

1160

1165

1170

1175

1180

1185

1190

1195

1200

1205

1210

1215

1220

1225

1230

1235

1240

1245

1250

1255

1260

1265

1270

1275

1280

1285

1290

1295

1300

1305

1310

1315

1320

1325

1330

1335

1340

1345

1350

1355

1360

1365

1370

1375

1380

1385

1390

1395

1400

1405

1410

1415

1420

1425

1430

1435

1440

1445

1450

1455

1460

1465

1470

1475

1480

1485

1490

1495

1500

1505

1510

1515

1520

1525

1530

1535

1540

1545

1550

1555

1560

1565

1570

1575

1580

1585

1590

1595

1600

1605

1610

1615

1620

1625

1630

1635

1640

1645

1650

1655

1660

1665

1670

1675

1680

1685

1690

1695

1700

1705

1710

1715

1720

1725

1730

1735

1740

1745

1750

1755

1760

1765

1770

1775

1780

1785

1790

1795

1800

1805

1810

1815

1820

1825

1830

1835

1840

1845

1850

1855

1860

1865

1870

1875

1880

1885

1890

1895

1900

1905

1910

1915

1920

1925

1930

1935

1940

1945

1950

1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

2065

2070

2075

2080

2085

2090

2095

2100

2105

2110

2115

2120

2125

2130

2135

2140

2145

2150

2155

2160

2165

2170

2175

2180

2185

2190

2195

2200

2205

2210

2215

2220

2225

2230

2235

2240

2245

2250

2255

2260

2265

2270

2275

2280

2285

2290

2295

2300

2305

2310

2315

2320

2325

2330

2335

2340

2345

2350

2355

2360

2365

2370

2375

2380

2385

2390

2395

2400

2405

2410

2415

2420

2425

2430

2435

2440

2445

2450

2455

2460

2465

2470

2475

2480

2485

2490

2495

2500

2505

2510

2515

2520

2525

2530

2535

2540

2545

2550

2555

2560

2565

2570

2575

2580

2585

2590

2595

2600

2605

2610

2615

2620

2625

2630

2635

2640

2645

2650

2655

2660

2665

2670

2675

2680

2685

2690

2695

2700

2705

2710

2715

2720

2725

2730

2735

2740

2745

2750

2755

2760

2765

2770

2775

2780

2785

2790

2795

2800

2805

2810

2815

2820

2825

2830

2835

2840

2845

2850

2855

2860

2865

2870

2875

2880

2885

2890

2895

2900

2905

2910

2915

2920

2925

2930

2935

2940

2945

2950

2955

2960

2965

2970

2975

2980

2985

2990

2995

3000

3005

3010

3015

3020

3025

3030

3035

3040

3045

3050

3055

3060

3065

3070

3075

3080

3085

3090

3095

3100

3105

3110

3115

3120

3125

3130

3135

3140

3145

3150

3155

3160

3165

3170

3175

3180

3185

3190

3195

3200

3205

3210

3215

3220

3225

3230

3235

3240

3245

3250

3255

3260

3265

3270

3275

3280

3285

3290

3295

3300

3305

3310

3315

3320

3325

3330

3335

3340

3345

3350

3355

3360

3365

3370

3375

3380

3385

3390

3395

3400

3405

3410

3415

3420

3425

3430

3435

3440

3445

3450

3455

3460

3465

3470

3475

3480

3485

3490

3495

3500

3505

3510

3515

3520

3525

3530

3535

3540

3545

3550

3555

3560

3565

3570

3575

3580

3585

3590

3595

3600

3605

3610

3615

3620

3625

3630

3635

3640

3645

3650

3655

3660

3665

3670

3675

3680

3685

3690

3695

3700

3705

3710

3715

3720

3725

3730

3735

3740

3745

3750

3755

3760

3765

3770

3775

3780

3785

3790

3795

3800

3805

3810

3815

3820

3825

3830

3835

3840

3845

3850

3855

3860

3865

3870

3875

3880

3885

3890

3895

3900

3905

3910

3915

3920

3925

3930

3935

3940

3945

3950

3955

3960

3965

3970

3975

3980

3985

3990

3995

4000

4005

4010

4015

4020

4025

4030

4035

4040

4045

4050

4055

4060

4065

4070

4075

4080

4085

4090

4095

4100

4105

4110

4115

4120

4125

4130

4135

4140

4145

4150

4155

4160

4165

4170

4175

4180

4185

4190

4195

4200

4205

4210

4215

4220

4225

4230

4235

4240

4245

4250

4255

4260

4265

4270

4275

4280

4285

4290

4295

4300

4305

4310

4315

4320

4325

4330

4335

4340

4345

4350

4355

4360

4365

4370

4375

4380

4385

4390

4395

4400

4405

4410

4415

4420

4425

4430

4435

4440

4445

4450

4455

4460

4465

4470

4475

4480

4485

4490

4495

4500

4505

4510

4515

4520

4525

4530

4535

4540

4545

4550

4555

4560

4565

4570

4575

4580

4585

4590

4595

4600

4605

4610

4615

4620

4625

4630

4635

4640

4645

4650

4655

4660

4665

4670

4675

4680

4685

4690

4695

4700

4705

4710

4715

4720

4725

4730

4735

4740

4745

4750

4755

4760

4765

4770

4775

4780

4785

4790

4795

4800

4805

4810

4815

4820

4825

4830

4835

4840

4845

4850

4855

4860

4865

4870

4875

4880

4885

4890

4895

4900

4905

4910

4915

4920

4925

4930

4935

4940

4945

4950

4955

4960

4965

4970

4975

4980

4985

4990

4995

5000

5005

5010

5015

5020

5025

5030

5035

5040

5045

5050</

3 der die Gateelektrode erzeugt werden soll, strukturiert wird,

eine Schicht eines Materials, das die Gateelektrode bildet, abgeschieden wird,

aus dieser Schicht ein Spacer (5) geätzt wird,

5

die Hilfschicht entfernt wird, und

der Spacer (5) als Gateelektrode verwendet wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß Silizid zur Spacerbildung eingesetzt wird.

10

3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß auf die Gateoxidschicht (2) eine Polysiliziumschicht (3) aufgebracht wird.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß Polysilizium im Plasma-CVD-Abscheideverfahren aufgebracht wird.

Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

